

882S

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")

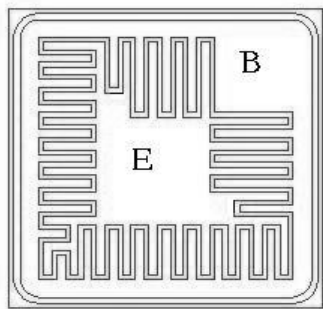
■用途:

- *中等功率放大器
- *中速开关应用

■特征:

- *集电极电流: 3A
- *有效图形数: 6700

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1050 μ m × 1050 μ m
压焊区尺寸	基区 310 μ m × 310 μ m 发射区 320 μ m × 320 μ m
芯片厚度	225 ± 10 μ m
锯片槽宽度	70 μ m
金属层	正面: Al 2.7 ± 0.2 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	40		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1mA, I_B=0$	30		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=100 \mu A, I_C=0$	6		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=32V, I_E=0$		500	nA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=4V, I_C=0$		500	nA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=2V, I_C=1A$	80	320	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=0.2A$		0.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A, f=10MHz$	80		MHz